

BU3150AF**硅 NPN 高反压大功率晶体管***** 主要用途：**

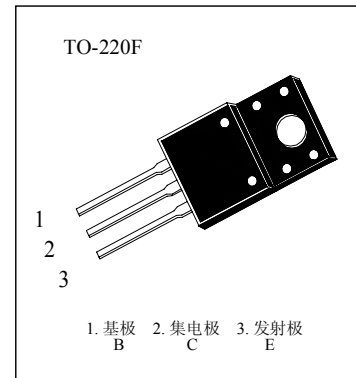
各类功率开关电路。

*** 主要特点：**

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

*** 封装形式：**

TO-220F



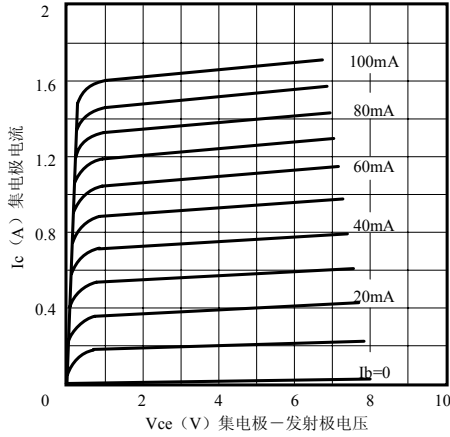
极限值：(T_c=25 °C)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极—发射极击穿电压	BV _{CEO}	≥ 800	V
集电极—基极击穿电压	BV _{CBO}	≥ 1100	V
发射极—基极击穿电压	BV _{EBO}	≥ 9	V
最大集电极直流电流	I _{cm}	3	A
最大耗散功率	P _{cm}	50	W
最高结温	T _{jm}	150	°C
贮存温度	T _{stg}	- 55 ~ 150	°C

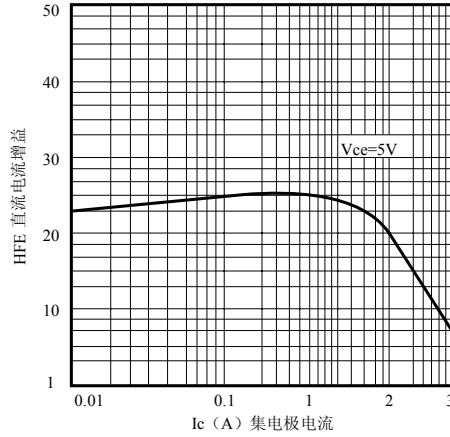
电特性：(T_c=25 °C)

参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
集电极—发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _c =1mA; I _B =0	800		V
集电极—基极击穿电压	BV _{CBO}	I _c =1mA; I _E =0	1100		V
发射极—基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =1mA; I _C =0	9		V
集电极—发射极反向漏电流	I _{CEO}	V _{CE} =700V; I _B =0		20	uA
集电极—基极反向漏电流	I _{CBO}	V _{CB} =1000V; I _E =0		10	uA
发射极—基极反向漏电流	I _{EBO}	V _{EB} =7V; I _C =0		10	uA
共发射极直流电流增益	H _{FE}	V _{CE} =5V; I _C =0.2A	10	40	
集电极—发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _C =1A; I _B =0.5A		0.6	V
下降时间	t _r	I _C =1A; I _{B1} =I _{B2} =0.2A; V _{CE} =300V		0.5	uS
特征频率	f _T	V _{CE} =10V; I _C =0.1A; f=1MHz		4	MHz

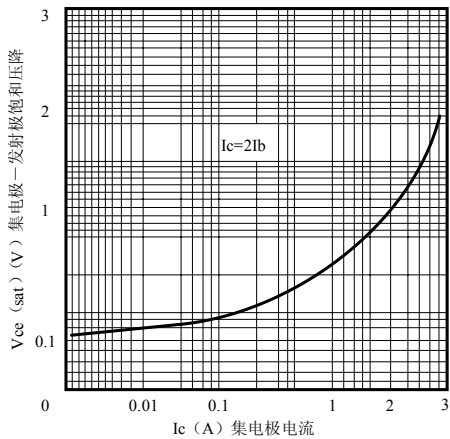
静态输出特性



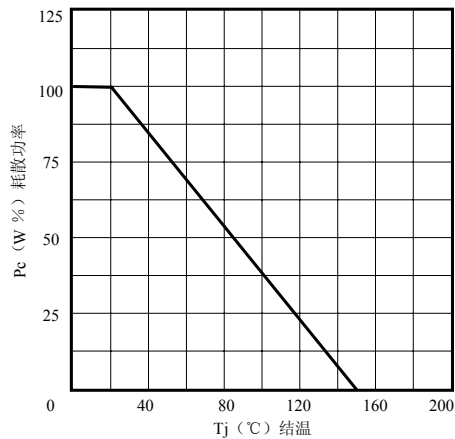
HFE 直流电流增益 - I_c 集电极电流



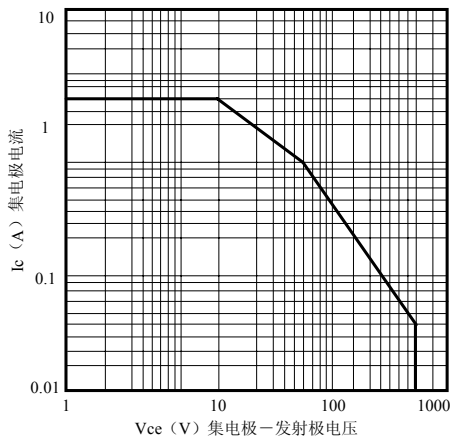
$V_{ce(sat)}$ 集电极-发射极饱和电压降 - I_c 集电极电流



P_c 耗散功率 - T_j 结温

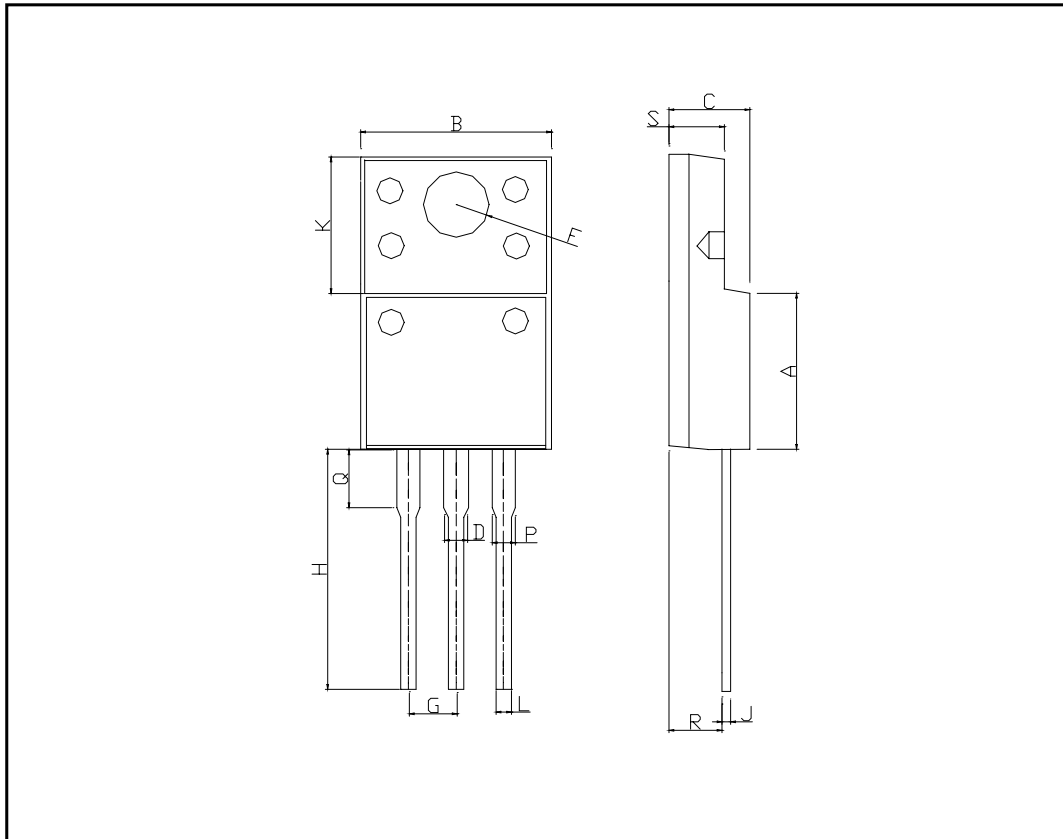


SOA (DC) 安全工作区



TO-220F 外形尺寸图

单位: mm



符 号	最小值	典型值	最大值
A	7.70	7.75	7.80
B	9.95	10.00	10.05
C	4.45	4.50	4.55
D	1.58	1.60	1.65
F	3.15	φ3.20	3.25
G		2.55	
H	13.2	13.35	13.4
J	0.58	0.60	0.62
K	6.90	6.95	7.00
L	0.58	0.60	0.62
P	1.18	1.20	1.25
Q	2.75	2.80	2.85
R	2.65	2.70	2.75
S	3.05	3.10	3.15